

مجاز است.

استفاده از:

Ch7

۱- اگر تمام نوارها به استثنای یک یا دو نوار که اندکی پر یا خالی اند کاملاً پر شده باشند، بلور چه نوعی است؟

د - ۱ و ۳

ج - نیمه رسانا

ب - فلز

الف - عایق

۲ - در یک بلور یک بعدی دومین گاف انرژی در چه بردار موجی رخ می دهد؟

$$k = \pm \frac{2\pi n}{a}$$

$$k = \pm \frac{\pi}{a}$$

$$k = \pm \frac{2\pi}{a}$$

$$k = \pm \frac{n\pi}{a}$$

۳- تعداد بردهای موج مجاز \vec{k} در منطقه اول بربیلونی یک شبکه مکعبی با تعداد یاخته بسیط N کدام است؟

د - $6N$ ج - $\frac{N}{2}$ ب - $2N$ الف - N

۴- برای موج ایستاده (+) در یک شبکه یک بعدی چگالی احتمال کدام است؟

$$\sin\left(\frac{\pi x}{a}\right)$$

$$\cos\left(\frac{\pi x}{a}\right)$$

$$\sin^2\left(\frac{\pi x}{a}\right)$$

$$\cos^2\left(\frac{\pi x}{a}\right)$$

۵- در مدل الکترون آزاد انرژی الکترونی با بردار موج $\vec{k} = \frac{\pi}{a} \hat{i}$ کدام است

$$\frac{\hbar^2 \pi^2}{ma^2}$$

$$\frac{2\hbar^2 \pi^2}{ma^2}$$

$$\frac{\hbar^2 \pi^2}{2ma^2}$$

$$\frac{\sqrt{2}\hbar^2 \pi^2}{ma^2}$$

Ch8

۶- کدام گزینه در تعریف گاف نواری یک نیمرسانا صحیح است؟

الف - اختلاف انرژی بین بالاترین نقطه نوار رسانش و پایین ترین نقطه نوار ظرفیت است.

ب - اختلاف انرژی بین پایین ترین نقطه نوار رسانش بالا ترین نقطه نوار ظرفیت است.

ج - اختلاف انرژی بین وسط نوار ظرفیت و وسط نوار رسانش است.

د - اختلاف انرژی بین نوار ظرفیت و وسط نوار رسانش است

مجاز است.

استفاده از:

۷- کدام گزینه درست است؟ (کامل‌تر است)

الف- لبه های نواری در Si با گذارهای غیر مستقیم به هم مربوط می شوند.ب- لبه های نواری در Ge با گذارهای غیر مستقیم به هم مربوط می شوند.ج- لبه های نواری در $InSb$ با یک گذار غیر مستقیم به هم مربوط می شوند.

د- الف و ب درست است

۸- مقدار $\frac{E}{Q}$ برابر است با:

$$grad T \quad - \quad \eta T \quad - \quad \frac{1}{T} \quad - \quad \text{الف}-T$$

۹- کدام گزینه صحیح است؟

الف- در یک نیمرسانی ذاتی جرم موثر الکترونهای باند رسانش و حفره های باند ظرفیت همواره با یکدیگر برابر است.

ب- در یک نیمرسانی ذاتی تراز فرمی در صفر مطلق نزدیک نوار رسانش قرار دارد.

ج- در یک نیمرسانی ذاتی تراز فرمی وسط گاف ممنوع قرار می گیرد اگر جرم موثر الکترونهای باند رسانش و حفره های

باند ظرفیت با یکدیگر برابر باشد.

د- در یک نیمرسانی نوع n تعداد الکترونهای باند رسانش و حفره های باند ظرفیت همواره با یکدیگر برابر است

مجاز است.

استفاده از:

۱۰- کدام گزینه صحیح است؟

الف- جرم موثر الکترون در یک بلور هموارخ مقدار ثابتی است.

ب- جرم موثر الکترونها و حفره ها در یک بلور هموارهمساوی است

ج- علامت جرم موثر الکترون هماره مثبت است.

د- جرم موثر الکترونها کمیتی تانسوری است.

Ch9

۱۱- شرط مرزی ویگز-ساتیس کدام است؟

$$\left[\frac{d\psi}{dr} \right]_{r_0} = 0 \quad \text{ب}$$

$$\left[\frac{d^2\psi}{dr^2} \right]_{r_0} = 0 \quad \text{الف}$$

$$\lim_{r \rightarrow \infty} \psi(r) = \infty \quad \text{د}$$

$$\left[\frac{d\psi}{dr} \right]_{r_0} = \left[\frac{d\psi}{dr} \right] \quad \text{ج}$$

۱۲- سطح فرمی سطحی است در فضایکه حالت‌هایرا از حالت‌های جدا می‌کند

ب- مکان - پر - خالی

الف- بردار موج- پر - خالی

د- مکان - نیمه پر - خالی

ج- بردار موج- نیمه پر - خالی



مجاز است.

استفاده از:

۱۳- علت ایجاد گافهای انرژی در موزهای منطقه کدام است؟ (کدام کامل‌تر است)

الف- بر هم کنش الکترون با پتانسیل دوره ای بلور

ب- بر هم کنش الکترون با الکترون‌های بلور

ج- بر هم کنش الکترون با میدانهای الکترو مغناطیسی

د- الف و ب

۱۴- مساحت یک مدار در فضای K کدام است ؟

$$(n + \gamma) \frac{4\pi \hbar c}{e} \quad \text{ب} \quad \left(\frac{\hbar c}{eb} \right)^2 \quad \text{الف}$$

$$(n + \gamma) \frac{4\pi e}{\hbar c} B \quad \text{د} \quad \frac{\hbar c}{e} \quad \text{ج}$$

۱۵- نوار انرژی با ساختار bcc به صورت $\epsilon_k = -\alpha - 2\gamma \cos k_x a$ است که در آن α, γ مقادیر ثابتی هستند، پهنه‌ای این نوار

کدام است ؟

د- 6γ ج- 4γ ب- 2γ الف- γ

Ch13

۱۶- پوسته ۴f مسئول چه خاصیتی در نمکهای گروه خاکی کمیاب می‌باشد؟

ب- فرومغناطیسی

الف- پارامغناطیسی

د- دیا مغناطیس

ج- آنتی فرومغناطیسی

مجاز است.

استفاده از:

۱۷- وابستگی بسامد مگنونها به بردار موج در حد بردار موجهای کوتاه کدام است؟

k^{-}

الف-

k^{-1}

د-

۱۸- در کوانتش امواج اسپینی انرژی مدی با فرکانس k و W مگنون کدام است؟

$\frac{\nu}{2}\hbar w_k$

$\frac{9}{2}\hbar w_k$

$2\hbar w_k$

$\frac{5}{2}\hbar w_k$

۱۹- در تقریب میدان میانگین هنگامی از پایین $T_c \rightarrow T$ مغناطیدگی متناسب است با:

$(T_c - T)^{-\frac{1}{4}}$

$(T_c - T)^{\frac{1}{4}}$

$(T_c + T)^{\frac{1}{4}}$

$(T_c - T)^{\frac{3}{4}}$

۲۰- یک آرایه خطی از ۸ اتم با اسپینهای موازی و یکسان S را در حالت فرومغناطیس در نظر بگیرید. انرژی حالت پایه در تقریب

نزدیکترین همسایه و مدل هایزنبرگ کدام است؟

$-8JS^2$

$\text{الف}-16JS^2$

$-22JS^2$

$\text{ج}-6JS^2$

مجاز است.

استفاده از:

سوالات تشریحی (بارم هر سوال ۷۵/۱ نمره)

۱. با استفاده از بسط تابع موج بلاخ و بسط پتانسیل تناوبی شبکه بر حسب امواج تخت نشان دهید که معادله شروعینکر به صورت زیر در می آید:

$$(\lambda_k - \epsilon)(ck) + \sum_G U_G c(K-G) = 0$$

۲. نشان دهید که جرم مؤثر از رابطه به دست می آید.

$$\frac{1}{m^*} = \frac{1}{\hbar^2} \frac{d^2 \epsilon}{dK^2}$$

۳. انواع نمایشگاهی منطقه‌ای را تعریف کرده و سه نوار اول یک شبکه خطی را در هر یک از این نمایشگاه ترسیم نمایید.

۴. سیستمی شامل N اسپین یکسان موضعی را در نظر بگیرید با استفاده از برهمکنش هایزنبرگ و با در نظر گرفتن برهمکنش نزدیکترین همسایه‌ها نشان دهید که در دماهای پایین رابطه پاشندگی به صورت زیر است:

$$\hbar w = \epsilon J_S (1 - \cos Ka)$$